

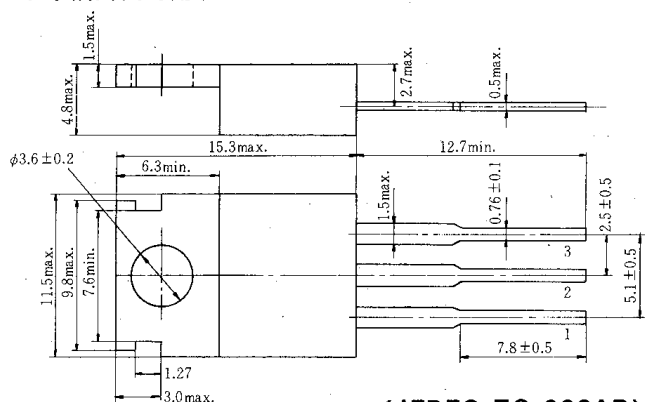
# 2SD976, 2SD976A

シリコン NPN 三重拡散形

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

電力スイッチング用  
TV 水平偏向出力用

POWER SWITCHING  
TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



(JEDEC TO-220AB)

1. ベース: Base
  2. コレクタ: Collector  
(フランジ) (Flange)
  3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

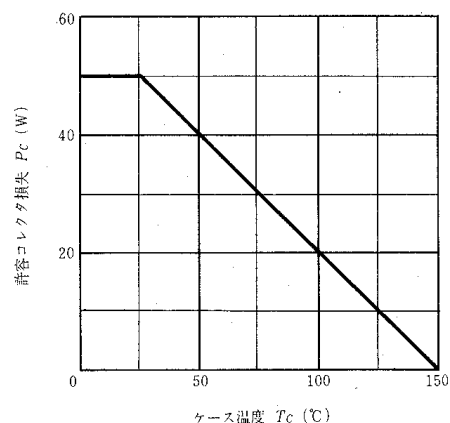
## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	2SD976	2SD976A	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	300	350	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	120	150	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	6		V
コレクタ電流	$I_C$	7		A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	10		A
サージコレクタ電流	$I_{C(\text{surge})}$	20		A
許容コレクタ損失	$P_C^*$	50		W
接合部温度	$T_j$	150		$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-45~+150		$^\circ\text{C}$

\*  $T_c=25^\circ\text{C}$  における許容値

\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	Test Condition	2SD976			2SD976A			Unit
			min	typ	max	min	typ	max	
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=100\text{mA}, R_{BE}=\infty$	120	—	—	150	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\text{mA}, I_C=0$	6	—	—	6	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=300\text{V}, I_E=0$	—	—	5	—	—	—	mA
		$V_{CB}=350\text{V}, I_E=0$	—	—	—	—	—	5	
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=5\text{A}$	25	—	—	25	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=5\text{A}, I_B=0.5\text{A}$	—	—	2.0	—	—	1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(\text{sat})}$		—	—	1.2	—	—	1.2	V
下降時間	$t_f$	$I_{CP}=3.5\text{A}, I_{B1}=0.45\text{A}$	—	—	0.5	—	—	0.5	$\mu\text{s}$